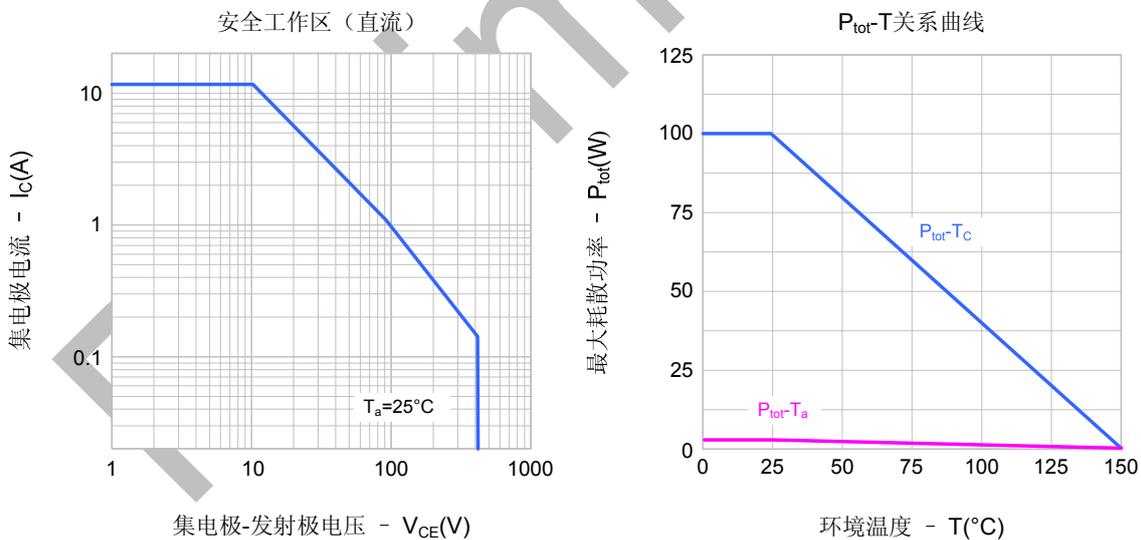


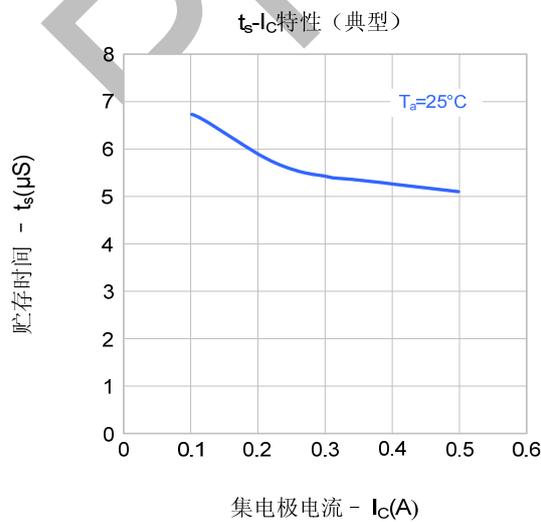
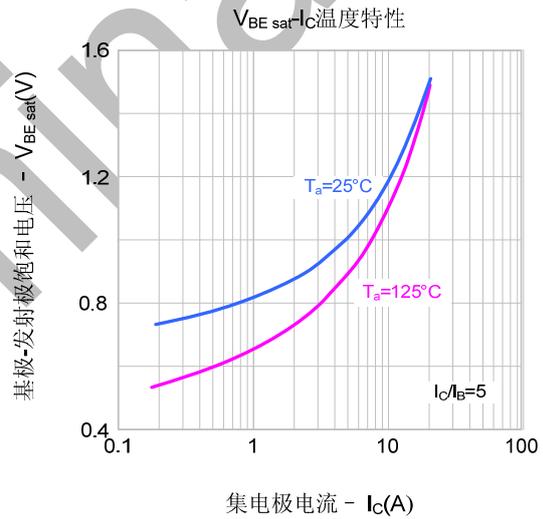
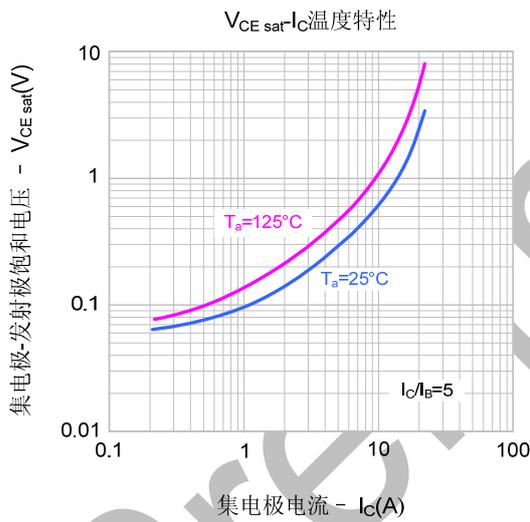
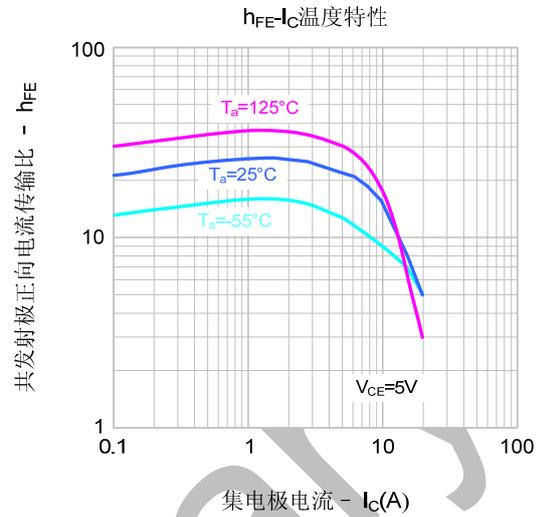
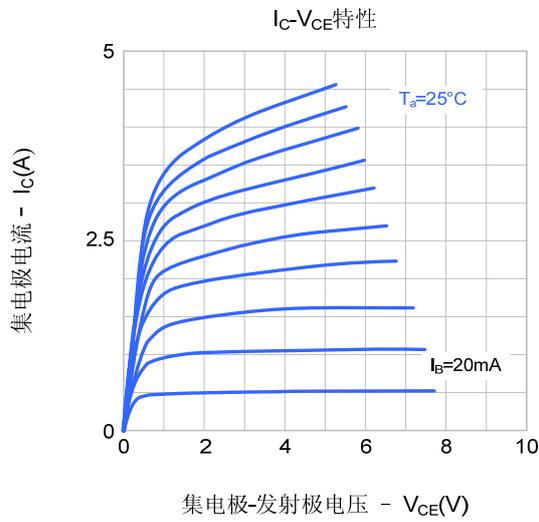
电参数(除非特殊说明, $T_C=25^{\circ}\text{C}$)

参 数	符 号	测 试 条 件	最 小 值	典 型	最 大 值	单 位
集电极-基极截止电流	I_{CBO}	$V_{CB}=700\text{V}, I_E=0$	--	--	100	μA
集电极-发射极截止电流	I_{CEO}	$V_{CE}=400\text{V}, I_B=0$	--	--	100	μA
发射极-基极截止电流	I_{EBO}	$V_{EB}=9\text{V}, I_C=0$	--	--	100	μA
集电极、基极电压	V_{CBO}	$I_C=0.1\text{mA}$	700	--	--	V
集电极、发射极电压	V_{CEO}	$I_C=1\text{mA}$	400	--	--	V
发射极、基极电压	V_{EBO}	$I_E=0.1\text{mA}$	9	--	--	V
共发射极正向电流传输比的静态值	h_{FE}	$V_{CE}=5\text{V}, I_C=3\text{A}$	15	--	35	--
集电极、发射极饱和压降	$V_{CE\text{ sat}}^*$	$I_C=5\text{A}, I_B=1.6\text{A}$	--	--	1.0	V
基极、发射极饱和压降	$V_{BE\text{ sat}}^*$	$I_C=5\text{A}, I_B=1.6\text{A}$	--	--	1.6	V
上升时间	t_r	UI9600, $I_C=0.5\text{A}$	--	--	0.6	μs
存储时间	t_s		4	--	7	μs
下降时间	t_f		--	--	0.25	μs
特征频率	f_T	$V_{CE}=10\text{V}, I_C=0.5\text{A}, f=1\text{MHz}$	4	--	--	MHz

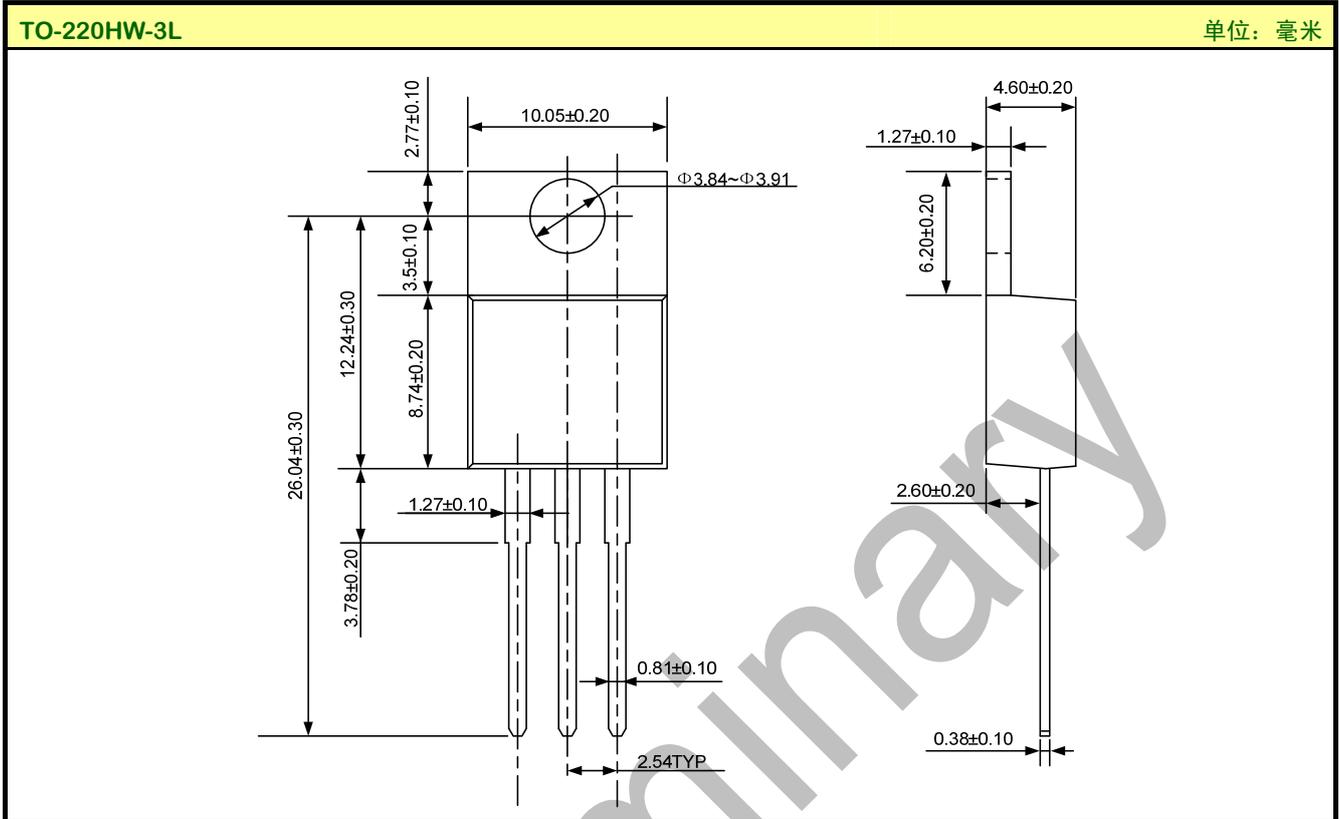
* 脉冲测试, 脉冲宽度 $tp \leq 300\mu\text{s}$, 占空比 $\delta \leq 2\%$

典型特性曲线


典型特性曲线 (续)



封装外形图



声明:

- ◆ 士兰保留说明书的更改权，恕不另行通知！客户在下单前应获取最新版本资料，并验证相关信息是否完整和最新。
- ◆ 任何半导体产品特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能，买方有责任在使用 Silan 产品进行系统设计和整机制造时遵守安全标准并采取安全措施，以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生！
- ◆ 产品提升永无止境，我公司将竭诚为客户提供更优秀的产品！



产品名称:	SJT13009NT	文档类型:	说明书
版 权:	杭州士兰微电子股份有限公司	公司主页:	http://www.silan.com.cn

版 本:	0.1	作 者:	马丽青
------	-----	------	-----

修改记录:

1. 初稿

Preliminary